

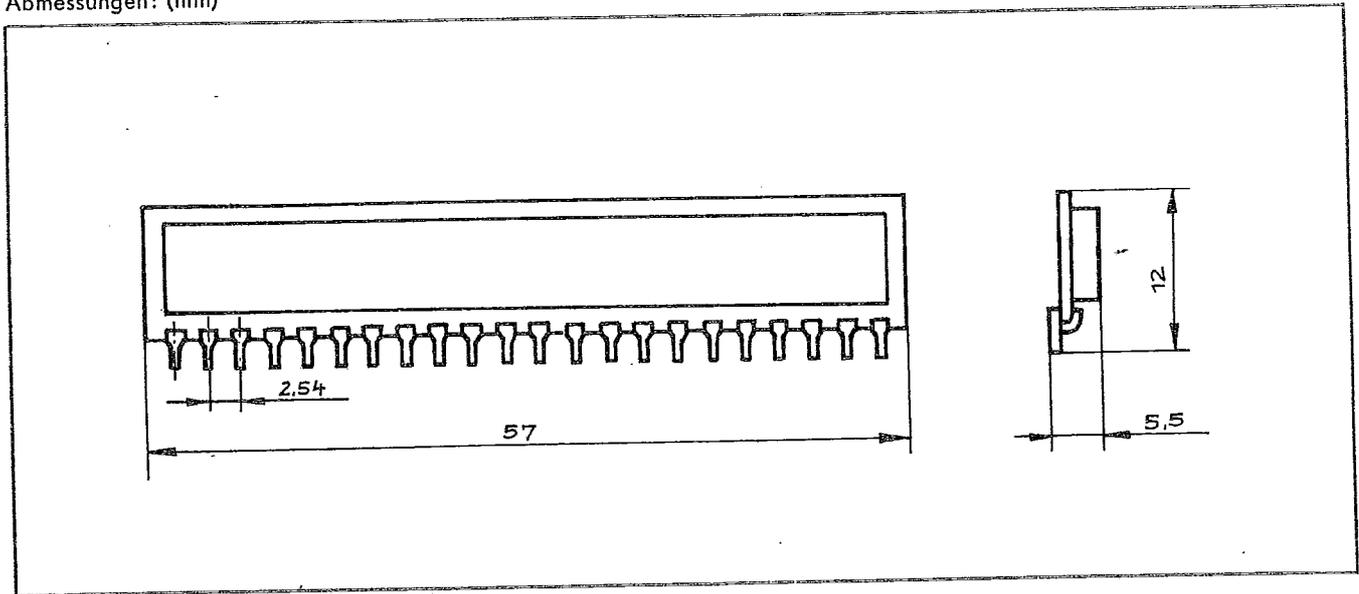
# DRAM 1 Mbit-Hybridspeicher

4 M 61256 A

Der Hybridschaltkreis ist ein hochintegrierter dynamischer Schreib-Lese-Speicher mit wahlfreiem Zugriff. Er verfügt über eine Speicherkapazität von 1 Mbit, die als Speicherblock von  $256\text{ K} \times 4\text{ bit}$  organisiert ist. Alle Ein- und Ausgänge sind TTL-kompatibel. Als Bauelemente werden die in CSGT 4-MOS-

Technologie gefertigten U 61256-Chips verwendet. Folgende Betriebsarten sind möglich: LESEZYKLUS, SCHREIBZYKLUS, LESE-SCHREIB-ZYKLUS, STATISCHER-SEITEN-ZUGRIFF (besonders für Bildwiederholpeicher von Vorteil). Die Bauform entspricht den internationalen SIP-Modulen.

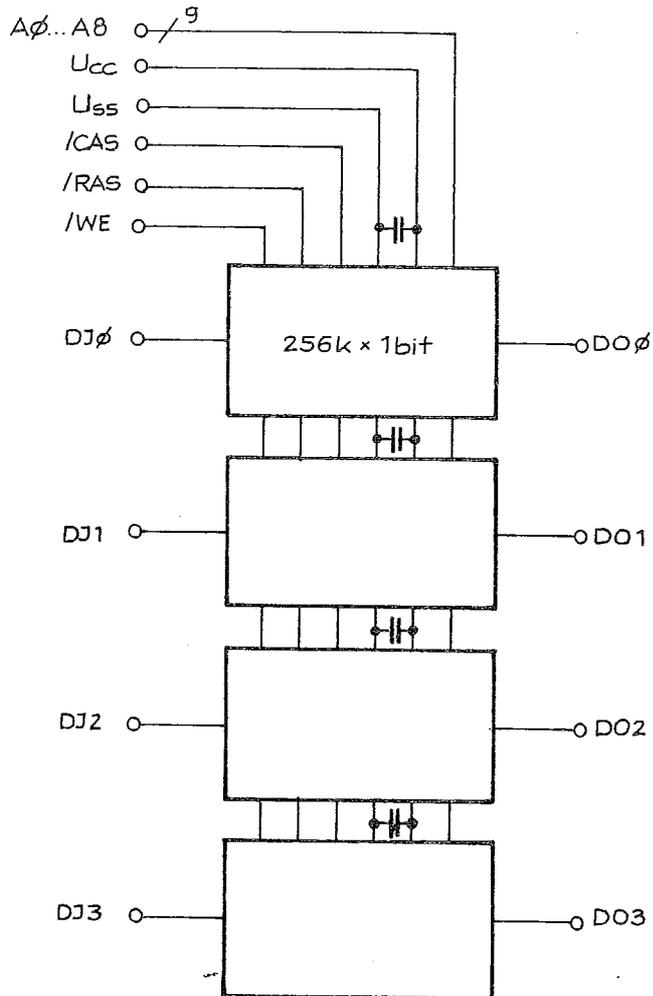
Abmessungen: (mm)



**Erzeugnisnummer:** 4547.8-3579.41  
**Typkurzzeichen:** 4735  
**Betriebsbedingungen**  
Betriebsspannung: 5 V  
H-Eingangsspannung:  $\geq 2,4\text{ V}$   
L-Eingangsspannung:  $\leq 0,8\text{ V}$   
Betriebstemperaturbereich:  $0 \dots 70\text{ }^\circ\text{C}$

**Kenngößen**  
Betriebsstrom:  $< 220\text{ mA}$   
Ruhestrom:  $< 20\text{ mA}$   
Zugriffszeit | RAS : 150 ns  
Zugriffszeit | CAS : 45 ns  
Adresszugriffszeit: 80 ns

Funktionsschaltbild



Anschlußbelegung

